

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 30.09.2023 16:41:18

Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98ac3de2ab454b4659d961f749

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Рабочая программа дисциплины (модуля) Структурные методы исследования наноматериалов

Закреплена за подразделением

Кафедра физического материаловедения

Направление подготовки

22.04.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль

Физика и технологии функциональных материалов

Квалификация

Магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану

108

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

зачет 1

аудиторные занятия

17

самостоятельная работа

91

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Неделя	18			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Практические	17	17	17	17
Итого ауд.	17	17	17	17
Контактная работа	17	17	17	17
Сам. работа	91	91	91	91
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

к.тн, доцент, Щетинин И.В.; старший преподаватель, Захарова Е.А.

Рабочая программа

Структурные методы исследования наноматериалов

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - магистратура Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 22.04.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (приказ от 05.03.2020 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, 22.04.01-ММТМ-22-7.plx Физика и технологии функциональных материалов, утвержденного Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, Физика и технологии функциональных материалов, утвержденной Ученым советом ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС" 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра физического материаловедения

Протокол от 11.04.2022 г., №8-04

Руководитель подразделения Савченко А.Г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Сформировать компетенции, предусмотренные учебным планом, и научить основам современных методов исследования материалов, пониманию возможностей этих методов, их точности, чувствительности, локальности и применимости с целью изучения связи между составом, структурой и свойствами и контроля качества материалов в наноструктурном состоянии.
-----	--

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Дифракционные и микроскопические методы	
2.2.2	Магнитомягкие материалы: технологии получения и обработки	
2.2.3	Методы исследования макро- и микроструктуры материалов	
2.2.4	Методы исследования материалов	
2.2.5	Физика магнетизма. Часть 2. Магнетизм материалов	
2.2.6	Атомное строение неорганических материалов	
2.2.7	Перспективные технологии функциональных материалов	
2.2.8	Спектроскопические и зондовые методы	
2.2.9	Физические методы исследования материалов	
2.2.10	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.11	Преддипломная практика	

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-4: Способен планировать, осуществлять комплексные исследования и разработку функциональных материалов (в том числе наноматериалов) различного назначения	
Знать:	
ПК-4-31 основные этапы планирования комплексного исследования материалов, находящихся в нанокристаллическом состоянии;	
ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи, на основе фундаментальных знаний в области материаловедения и технологии материалов и знаний в междисциплинарных областях	
Знать:	
ОПК-1-31 современные представления о дифракции рентгеновского и других видов излучения, также закономерности взаимодействия оптического и электронного излучения для интерпретации и анализа дифракционных спектров, полученных при различных условиях съемки;	
ПК-4: Способен планировать, осуществлять комплексные исследования и разработку функциональных материалов (в том числе наноматериалов) различного назначения	
Уметь:	
ПК-4-У1 выбирать и реализовывать методы анализа, для изучения фазового состава, а также структуры наноматериалов;	
ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи, на основе фундаментальных знаний в области материаловедения и технологии материалов и знаний в междисциплинарных областях	
Уметь:	
ОПК-1-У1 устанавливать фазовый состав и тонкую структуру материалов в наноструктурном и микрокристаллическом состоянии;	
ПК-4: Способен планировать, осуществлять комплексные исследования и разработку функциональных материалов (в том числе наноматериалов) различного назначения	
Владеть:	
ПК-4-В1 умением устанавливать возможные причины формирования тех или иных физико-химических состояний и свойств изделий;	
ОПК-1: Способен решать производственные и (или) исследовательские задачи, на основе фундаментальных знаний в области материаловедения и технологии материалов и знаний в междисциплинарных областях	
Владеть:	
ОПК-1-В1 самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в практических ситуациях;	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ								
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Рассеяние рентгеновских лучей идеальным и реальным кристаллом							
1.1	Рассеяние идеальным (бездефектным) кристаллом. Условия Лауэ. Основные характеристики профиля рентгеновской линии. Интенсивность отражений. /Пр/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.1			Р1
1.2	Рассеяние кристалла с дефектами. Модель субструктуры. Влияние дефектов и дисперсности ОКР на ширину и профиль рентгеновских линий. /Пр/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.1		КМ1	Р2
1.3	Теоретический расчет дифрактограмм. Выбор условий съемки. /Ср/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.4 Л2.5Л3.1			
1.4	Подготовка к практическим занятиям по разделу. /Ср/	1	8	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.1 Э1 Э2 Э3			
1.5	Подготовка к контрольной работе: Рассеяние рентгеновских лучей /Ср/	1	8	ОПК-1-31 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.4 Л2.5Л3.1		КМ1	
	Раздел 2. Анализ структуры наноматериалов по уширению дифракционных линий							
2.1	Анализ структуры наноматериалов по интегральной ширине рентгеновской линии (метод «классической» аппроксимации) /Пр/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.1			Р3
2.2	Анализ структуры наноматериалов по профилю двух линий (ГАПРЛ). Анализ субструктуры наноматериалов методом Фойгт-аппроксимации /Пр/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л3.1			Р4
2.3	Рентгеноструктурный анализ поверхностного слоя. Толщина эффективно поглощающего слоя. Другие методы анализа уширения дифракционных линий /Пр/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л3.1		КМ2	Р5
2.4	Комплексная работа. Анализ параметров тонкой структуры по ширине дифракционных линий /Ср/	1	6	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л3.1 Э1 Э3			
2.5	Подготовка к практическим занятиям по разделу /Ср/	1	10	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.1 Э1 Э3			

2.6	Подготовка к контрольной работе: Анализ структуры по ширине дифракционной линии /Ср/	1	8	ОПК-1-31 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.5Л3.1		КМ2	
Раздел 3. Рентгеновский фазовый анализ								
3.1	Рентгеновский фазовый анализ (качественный и количественный) с применением ЭВМ. Комплексный анализ фазового состава и параметров тонкой структуры методом Ритвельда. /Пр/	1	3	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.4 Л2.5Л3.1		КМ3	Р6
3.2	Качественный и количественный фазовый анализ с использованием компьютерных программ. /Ср/	1	4	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э2			
3.3	Подготовка к практическому занятию по разделу /Ср/	1	7	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1			
3.4	Подготовка к контрольной работе: Рентгеновский фазовый анализ /Ср/	1	8	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.4 Л2.5Л3.1		КМ3	
Раздел 4. Применение микроскопии для исследования материалов								
4.1	Оптическая микроскопия /Ср/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1			
4.2	Просвечивающая электронная микроскопия /Ср/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1			
4.3	Растровая электронная микроскопия /Ср/	1	2	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.1			
4.4	Комплексная работа. Современные оптическая и электронная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. /Пр/	1	4	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1		КМ4	Р7
4.5	Подготовка к контрольной работе: Микроскопия /Ср/	1	12	ОПК-1-31 ОПК-1-У1 ОПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2Л3.1		КМ4	
4.6	Подготовка к комплексной работе по разделу Применение микроскопии для исследования материалов. /Ср/	1	12	ОПК-1-31 ОПК-1-В1 ПК-4-31 ПК-4-У1 ПК-4-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э3			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
--------	-------------------------	------------------------------------	------------------------

КМ1	Контрольная работа 1	ОПК-1-31;ОПК-1-В1	Какой кристалл называется идеальным? Рассеяние идеальным кристаллом. Условия Лауэ. Основные характеристики профиля рентгеновской линии. Интенсивность отражений. Рассеяние кристалла с дефектами. Модель субструктуры. Перечислите дефекты решетки. Классификации дефектов Влияние дисперсности ОКР на ширину рентгеновской линии; Влияние дефектов на ширину рентгеновской линии; Влияние дефектов на профиль рентгеновских линий.
КМ2	Контрольная работа 2	ОПК-1-31;ОПК-1-У1;ОПК-1-В1	Перечислите методы анализа уширения дифракционных линий Анализ структуры наноматериалов по интегральной ширине рентгеновской линии (метод «классической» аппроксимации) Анализ структуры наноматериалов по профилю двух линий (ГАПРЛ). Анализ субструктуры наноматериалов методом Фойгт-аппроксимации Рентгеноструктурный анализ поверхностного слоя. Толщина эффективно поглощающего слоя.
КМ3	Контрольная работа 3	ОПК-1-31;ОПК-1-У1;ПК-4-У1	Рентгеновский фазовый анализ качественный. Рентгеновский фазовый анализ количественный. Метод Ритвельда. Комплексный анализ фазового состава и параметров тонкой структуры.
КМ4	Контрольная работа 4	ОПК-1-31;ОПК-1-У1;ОПК-1-В1	Оптическая микроскопия Растровая электронная микроскопия Просвечивающая электронная микроскопия Атомно-силовая микроскопия

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)

Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Рассеяние идеальным (бездефектным) кристаллом. Условия Лауэ. Основные характеристики профиля рентгеновской линии. Интенсивность отражений. /Пр/	ОПК-1-31	
P2	Рассеяние кристалла с дефектами. Модель субструктуры. Влияние дефек -тов и дисперсности ОКР на ширину и профиль рентгеновских линий. /Пр/	ОПК-1-31	

P3	Анализ структуры наноматериалов по интегральной ширине рентгеновской линии (метод «классической» аппроксимации) /Пр/	ОПК-1-31;ОПК-1-У1	
P4	Анализ структуры наноматериалов по профилю двух линий (ГАПРЛ). Анализ субструктуры наноматериалов методом Фойгт-аппроксимации /Пр/	ОПК-1-31	
P5	Рентгеноструктурный анализ поверхностного слоя. Толщина эффективно поглощающего слоя. Другие методы анализа уширения дифракционных линий /Пр/	ОПК-1-У1	
P6	Рентгеновский фазовый анализ (качественный и количественный) с применением ЭВМ. Комплексный анализ фазового состава и параметров тонкой структуры методом Ритвельда. /Пр/	ОПК-1-31;ОПК-1-У1;ПК-4-У1	
P7	Комплексная работа. Современные оптическая и электронная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. /Пр/	ОПК-1-31;ПК-4-В1;ПК-4-У1;ПК-4-31	

5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

экзамен по курсу не предусмотрен

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По дисциплине предусмотрен зачет. Зачет ставится при условии выполнения четырех контрольных работ (на оценку "удовлетворительно" или выше).
оценка "незачет" студент не справился с выполнением календарного плана, выполнил и/или защитил не все практические работы, контрольные мероприятия выполнены на оценку "неудовлетворительно";
оценка "неявка" студент не явился на контрольные мероприятия в семестре.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Иванов А. Н., Расторгуев Л. Н.	Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Учебник для вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1982
Л1.2	Брандон Д., Каплан У., Баженов С. Л., Егорова С. В.	Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля: учеб. пособие для студ. напр. 'Прикладные математика и физика': пер. с англ.	Библиотека МИСиС	М.: Техносфера, 2004
Л1.3	Горелик С. С., Скаков Ю. А., Расторгуев Л. Н.	Рентгенографический и электронно-оптический анализ: учеб. пособие для вузов	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2002

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Миркин Л. И., Уманский Я. С.	Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов: справочник	Электронная библиотека	Москва: Государственное издательство физико- математической литературы, 1961
Л2.2	Панова Т. В.	Современные методы исследования вещества: электронная и оптическая микроскопия: учебное пособие	Электронная библиотека	Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016
Л2.3	Домкин К. И.	Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий: методы и применение: монография	Электронная библиотека	Москва: Лаборатория знаний, 2017
Л2.4	Бублик В. Т., Мильвидский А. М.	Методы исследования материалов и структур электроники. Рентгеновская дифракционная микроскопия: курс лекций	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2006
Л2.5	Уманский Я. С.	Рентгенография металлов и полупроводников: учеб. пособие для студ. металлург. спец. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1969

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Векилова Г. В., Иванов А. Н., Ягодкин Ю. Д.	Дифракционные и микроскопические методы и приборы для анализа наночастиц и наноматериалов: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 'Металлургия'	Электронная библиотека	М.: [МИСиС], 2009

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Научная электронная библиотека eLIBRARY	http://elibrary.ru/
Э2	Inorganic Crystal Structure Database:	https://p1.misis.ru:5019/RPD/Index/1685435/%20http://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html
Э3	РЕСУРСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА Springer Nano -ресурс содержит информацию о наноматериалах и наноустройствах	http://nano.nature.com/

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	Microsoft Office
П.2	LMS Canvas
П.3	MS Teams
П.4	ESET NOD32 Antivirus

П.5	Win Pro 10 32-bit/64-bit
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных	
И.1	научометрическая система InCites https://apps.webofknowledge.com
И.2	Springer materials https://materials.springer.com/
И.3	International Centre for Diffraction Data http://www.icdd.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 50 рабочих мест, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета
Б-016	Международная школа микроскопии:	просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM-1400 (STEM conf.); сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-IT500LA (+JEOL EDS); атомно-силовой микроскоп AIST-NT SmartSPM-1000 (AFM, MFM, SPM); комплекс пробподготовки в составе: JEOL IonSlicer-9100IS; Struers Tenupol-5 с криостатом; Struers Lectropol-5 с криостатом. Зал на 11 рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами с подключением сети "Интернет" и электронной информационно-образовательной среде университета, пакет лицензионных программ MS Office, комплект учебной мебели, проектор (2 шт), интерактивная доска, экран
Б-011	Центр коллективного пользования "Материаловедение и металлургия":	сканирующий электронный микроскоп JSM 6700 F JEOL, сканирующий электронный микроскоп JSM 6480 LV JEOL, электронный оже-спектрометр PHI-680 Physical electronics
Б-416	Учебный комплекс по структурной диагностике и материаловедческой экспертизе неорганических материалов методами оптической микроскопии:	проектор; экран; маркерная доска; компьютер преподавателя; микроскоп Carl Zeiss Axio Scope A1, компьютерный класс на 12 компьютеров, комплект учебной мебели
Б-400	УНЛ "Центр рентгеноструктурных исследований и диагностики материалов":	дифрактометры: ДРОН-4, Rigaku MiniFlex, Rigaku Ultima IV, Rigaku SmartLab; установка измерения физических свойств Quantum Design PPMS; вакуумные печи; высокоэнергетические мельницы; мессбауэровский спектрометр

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении курса "Структурные методы исследования наноматериалов" магистрам большое внимание следует уделить самостоятельной работе с учебниками, справочной литературой и текущими публикациями в ведущих российских и зарубежных журналах по рассматриваемым темам курса. Большую часть вопросов, возникающих в процессе самостоятельной подготовки, рекомендуется выносить для обсуждения на практических занятиях.

Обучение проводится в один семестр и организуется в соответствии с настоящей программой. Самостоятельная работа студентов осуществляется и контролируется с помощью:

- вопросов для самоконтроля,
- четырех письменных контрольных работ.

Контрольные работы проводятся в часы практических занятий.

Для успешного освоения изучаемой дисциплины для студентов организуются консультации преподавателей.